

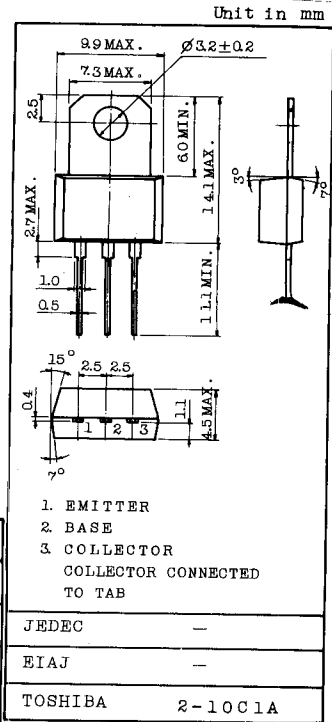
2SA818

シリコンPNP 三重拡散形トランジスタ (PCT方式)
SILICON PNP TRIPLE DIFFUSED TRANSISTOR (PCT PROCESS)

- 高耐圧励振増幅用
- High Voltage Driver Stage Amplifier Applications
- 高耐圧です: $V_{CEO} = -150V$
- コレクタ出力容量が小さい: $C_{ob} = 5.0pF$ (Max.)
- トランジション周波数が高い: $f_T = 120MHz$ (Typ.)
- 2SC1628とコンプリメンタリになります。
- Complementary to 2SC1628

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-180	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-150	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-50	mA
エミッタ電流	I_E	50	mA
コレクタ損失	P_C	1	W
接合温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ C$



* PCT技術により製造されています。
Produced by Perfect Crystal Device Technology.

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -100V, I_E = 0$	-	-	-1.0	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	-	-	-1.0	μA
直流電流増幅率 (Note)	h_{FE}	$V_{CE} = -5V, I_C = -10mA$	70	-	240	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -30mA, I_B = -3mA$	-	-	-2.0	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -5V, I_C = -30mA$	-	-	-0.9	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -10V, I_E = 10mA$	40	120	-	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10V, I_E = 0,$ $f = 1MHz$	-	-	5.0	pF

Note : h_{FE} により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of h_{FE} , the 2SA818 is classified as follows.

CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SA818-0	70	140
2SA818-Y	120	240

2SA818

STATIC CHARACTERISTICS

